

SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595D(文件编号: S&CIC1040)

3态8位移位寄存器

一、概述

74HC595是一颗高速CMOS 8位3态移位寄存器/输出锁存器芯片,采用CMOS硅栅工艺。该器件包含一个8位串行输入与并行输出移位寄存器并提供一个8位D型存储寄存器,该存储寄存器具有8位3三态输出。分别提供独立的时钟信号给移位寄存器和存储寄存器,移位寄存器具有直接清零功能和串行输入输出功能以及级联应用.(采用标准引脚。)移位寄存器和存储寄存器均为使用正边缘时钟触发,如果这两个时钟连接在一起,移位寄存器始终在存储寄存器的前一个时钟脉冲。所有输入端口均设有防静电及瞬间过压保护电路。

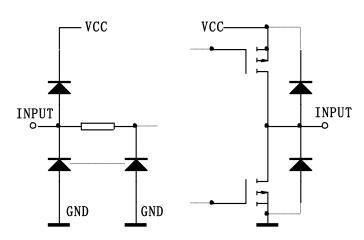
二、特性

- ▶ 高速率传输, 在VDD等于6V时最大数据传输速率可达59M。
- ▶ 低功耗,环境温度25℃时,Icc最大电流仅为4uA。
- ➤ 高抗扰度 V_{NIH} = V_{NIL} = 28% VCC (最小);
- ➤ 对称输出阻抗 |I_{OH}| = I_{OL} = 6mA (最小) 指AQ~QH端口; |I_{OH}| = I_{OL} = 4mA (最小)指QH'端口。
- ▶ 传播延迟平衡: t_{PLH} t_{PHL}。
- ▶ 宽范围工作电压,从 2V~6V。
- ▶ 脚位及功能与74系列之595完全兼容。

三、 产品应用

▶ LED广告显示屏, LED数码屏等。

四、 输入输出等效电路



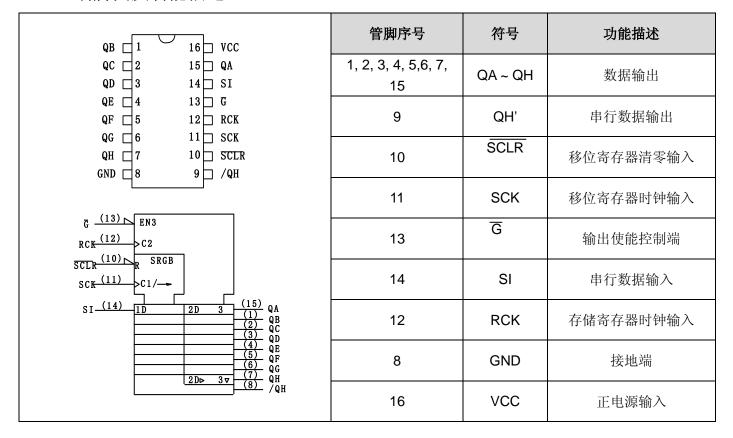


SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595D(文件编号: S&CIC1040)

3态8位移位寄存器

引脚图及功能描述 五、



六、 真值表

		输入			输出
SI	SCK	SCLR	RCK	G	
Х	Х	Х	Х	Н	禁止 QA ~QH 输出
Х	Х	Х	Х	L	启动 QA ~QH 输出
Х	Х	L	Х	Х	存储器复位
Х		Н	Х	Х	在 SCK 的上升沿将数据储存到存储器里
X		Н	Х	Х	存储器状态不可改变
Х	Х	Х		Х	在 RCK 的上升沿将数据储存到锁存器里
Х	X	Х		X	锁存器的状态不可改变

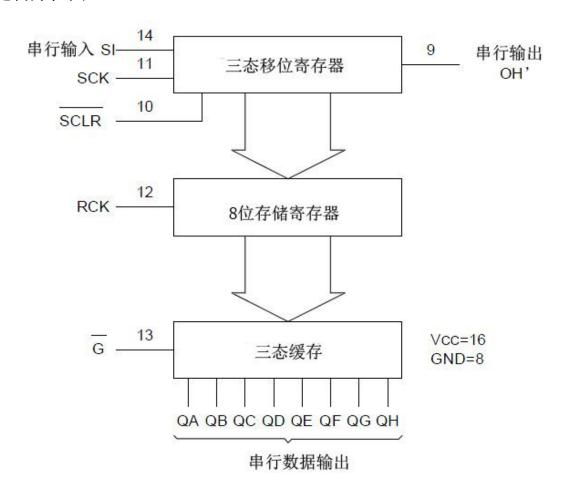


SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

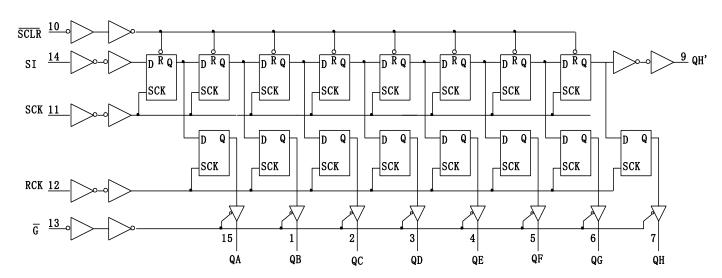
74HC595D(文件编号: S&CIC1040)

3态8位移位寄存器

七、 逻辑方框图



八、 逻辑电路图



^{*}此逻辑图不用作估算传播延时时间.

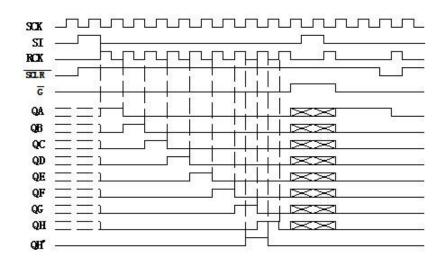


SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595D(文件编号: S&CIC1040)

3态8位移位寄存器

九、 时序图



此图表示高阻抗时段. (注:)

最大额定值 十、

符号	特性	参数值	单位
Vcc	工作电压	-0.5 ~ +7	V
VI	直流输入电压	-0.5 ~Vcc+0.5	V
Vo	直流输出电压	-0.5 ~Vcc+0.5	V
llk	直流正向输入	±20	mA
lok	直流正向输出	±20	mA
lo	直流输出电流	±35	mA
Icc or I _{GND}	VCC 或 GND 电流	±70	mA
Pd	功耗	500(*)	mW
Tstg	储存温度	-65 ~+150	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
TL	焊接温度(10 秒)	300	$^{\circ}\!\mathbb{C}$

建议使用值

符号	特性	<u>生</u>	参数值	单位
Vcc	工作电压		2 ~ 6	V
VI	输入电压		0~ Vcc	V
Vo	输出电压		0 ~Vcc	V
Topt	工作温度		-55 ~125	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
		Vcc=2.0V	0 ~1000	ns
tr, tf	输入转变时间	Vcc=4.5V	0 ~ 500	ns
		Vcc=6.0V	0 ~ 400	ns



SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595D(文件编号: S&CIC1040)

3态8位移位寄存器

直流特性 +-,

			测试条件	测试值							
符号	特性	特性 Vcc			T _A =25℃		-40 ~	85℃	-55 ~	125℃	単位
		(V)		最小	典型	最大	最小	最大	最小	最大	
		2.0		1.5			1.5		1.5		
V_{IH}	高电平输入	4.5		3.15			3.15		3.15		V
		6.0		4.2			4.2		4.2		
		2.0				0.5		0.5		0.5	
V_{IL}	低电平输入	4.5				1.35		1.35		1.35	V
		6.0				1.8		1.8		1.8	
		2.0	lo=-20uA	1.9	2.0		1.9		1.9		
	宣山亚松山	4.5	lo=-20uA	4.4	4.5		4.4		4.4		
V_{OH}	高电平输出 (指 QH'端的输出)	6.0	lo=-20uA	5.9	6.0		5.9		5.9		V
	(有以下 编的制造)	4.5	lo=-6.0mA	4.18	4.31		4.13		4.10		
		6.0	lo=-7.8mA	5.68	5.8		5.63		5.60		
	NoH 高电平输出 (指 QA 到 QH 端)	2.0	lo=-20uA	1.9	2.0		1.9		1.9		V
		4.5	lo=-20uA	4.4	4.5		4.4		4.4		
V_{OH}		6.0	lo=-20uA	5.9	6.0		5.9		5.9		
		4.5	lo=-6.0mA	4.18	4.31		4.13		4.10		
		6.0	lo=-7.8mA	5.68	5.8		5.63		5.60		
		2.0	lo=20uA		0.0	0.1		0.1		0.1	
	 低电平输出	4.5	lo=20uA		0.0	0.1		0.1		0.1	V
V_{OL}		6.0	lo=20uA		0.0	0.1		0.1		0.1	
		4.5	Io=6.0mA		0.17	0.26		0.33		0.40	
		6.0	Io=7.8mA		0.18	0.26		0.33		0.40	
		2.0	lo=20uA		0.0	0.1		0.1		0.1	
	 低电平输出	4.5	lo=20uA		0.0	0.1		0.1		0.1	
V_{OL}	(指 QA 到 QH 端)	6.0	lo=20uA		0.0	0.1		0.1		0.1	V
		4.5	Io=6.0mA		0.17	0.26		0.33		0.40	
		6.0	Io=7.8mA		0.18	0.26		0.33		0.40	
l _l	输入漏电流	6.0	VI = Vcc or GND			±0.1		±1		±1	uA
l _{oz}	高阻抗输出漏电流	6.0	$VI = V_{IH} \text{ or } V_{IL}$			±0.5		±5		±10	uA
IOZ	1년 1년 기가에 나를 살다	0.0	Vo = Vcc or GND			±0.0		10		±10	uA
I _{CC}	静态电流	6.0	VI = Vcc or GND			4		40		80	uA



SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595D(文件编号: S&CIC1040)

3态8位移位寄存器

十二、 交流特性(CL = 50pF,输入 $t_t = t_f = 6ns$)

符号 限分		TAN MA()	条件				测试值					
עאן בינו	定特性	Vcc	CL			T _A =25℃	;	-40 ~	85℃	-55 ~	125℃	单位
		(V)	(pF)		最小	典型	最大	最小	最大	最小	最大	
(0	A () ()	2.0	50			25	60		75		90	
Territoria	A-QH) 转变时间	4.5				7	12		15		18	ns
制出:	特 受时间	6.0				6	10		13		15	
//	2011)	2.0				30	75		95		115	
Trou Trou	SQH) 转变时间	4.5	50			8	15		19		23	ns
制造:	特 发的间	6.0				7	13		16		20	
(00	K OLUN#	2.0				45	125		155		190	
I focus focus	K-QH')传	4.5	50			15	25		31		38	ns
	E时时间	6.0				13	21		26		32	
(00)	I D. O.L.IV	2.0				60	175		220		265	
I tour tour	LR-QH')	4.5	50			18	35		44		53	ns
行換处	传播延时时间	6.0				15	30		37		45	1
	(RCK-Qn)传 播延时时间	2.0				60	150		190		225	
		4.5	50			20	30		38		45	ns
(RCI		6.0				17	26		32		38	
t _{PLH} t _{PHL} 播迎		2.0	150			75	190		240		285	
		4.5				25	38		48		57	ns
		6.0				22	32		41		48	
		2.0				45	135		170		205	
		4.5	50	$R_L = 1K\Omega$		15	27		34		41	ns
高阻抗	抗输出开	6.0				13	23		29		35	
t _{PZL} t _{PZH}	启时间	2.0				60	175		220		265	
		4.5	150	$R_L = 1K\Omega$		20	35		44		53	ns
		6.0				17	30		37		45	
÷70.	L	2.0				30	150		190		225	
	抗输出关	4.5	50	$R_L = 1K\Omega$		15	30		38		45	ns
	时间	6.0				14	26		32		38	
		2.0			6.0	17		4.8		4		
		4.5	50		30	50		24		20		MHz
	n l.b.l.⊪r→	6.0			35	59		28		24		
f _{MAX} 最高	时钟频率	2.0			5.2	14		4.2		3.4		
		4.5	150		26	40		21		17		MHz
		6.0			31	45		25		20		
最	小脉宽	2.0	5 0			17	75		95		110	
Trazzon	K, RCK)	4.5	50			6	15		19		22	ns



SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595D(文件编号: S&CIC1040)

3态8位移位寄存器

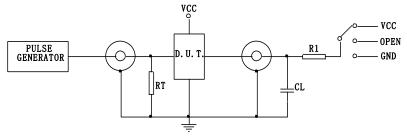
										· ,,	<u> </u>	14 111
		6.0				6	13		16		19	
		2.0				20	75		95		110	
$t_{W(L)}$	(SCLR)最小脉	4.5	50			6	15		19		22	ns
	宽	6.0				6	13		16		19	
	(SI-CCK)	2.0				25	50		65		75	
ts	最小启动时间	4.5	50			5	10		13		15	ns
		6.0				4	9		11		13	
	(SCK-RCK)	2.0				35	75		95		110	
ts	最小启动时间	4.5	50			8	15		19		22	ns
	取小石纫时间	6.0				6	13		16		19	
	(000) 00(0)	2.0				40	100		125		145	
ts	(SCRL-RCK) 最小启动时间	4.5	50			10	20		25		29	ns
	取小后纫时间	6.0				7	17		21		25	
		2.0					0		0		0	
t_h	最小维持时间	4.5	50				0		0		0	ns
		6.0					0		0		0	
		2.0				15	50		65		75	ns
t_{REM}	最小复位时间	4.5	50			3	10		13		15	
		6.0				3	9		11		13	

注: 启动时间指波形脉冲的启动时间.

十三、 输入电容特性

		测试值								
符号	特性	T _A =25℃			-40 ~	85 ℃	-55 ~	单位		
		最小	典型	最大	最小	最大	最小	最大		
CIN	输入电容		5	10		10		10	皮法	
CPD	功率耗散电容		184						皮法	

十四、 测试电路



测试	转换
t _{PLH} t _{PHL}	开路
t _{PZL} t _{PLZ}	接电源正
t _{PZH} t _{PHZ}	接地



SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595D(文件编号: S&CIC1040)

3态8位移位寄存器

LC=50-150PF 或相当于此值的容量 (包含测试架与探针之分布电容)

R1=1K Ω 或相当于 1K Ω 的电阻值.

RT=脉冲产生器的 Zout. (典型值= 50Ω)

十五、 封装尺寸图

